# Статистика электронов в PbS с U-центрами

© С.А. Немов, Ф.С. Насрединов, П.П. Серегин, Н.П. Серегин, Э.С. Хужакулов\*

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет,

195251 Санкт-Петербург, Россия

\* Ташкентский областной государственный педагогический институт,

702500 Ангрен, Узбекистан

(Получена 14 мая 2004 г. Принята к печати 24 мая 2004 г.)

С использованием распределения Гиббса получена зависимость концентрации промежуточного зарядового состояния  $\mathrm{Sn}^{3+}$  двухэлектронных центров олова в PbS от корреляционной энергии. Показано, что такое состояние олова не может быть обнаружено с помощью мессбауэровской спектроскопии на изотопе <sup>119</sup>Sn (из-за недостаточной чувствительности), однако оно может проявиться в температурной зависимости концентрации дырок в твердых растворах  $\mathrm{Pb}_{1-x-y} \mathrm{Sn}_x \mathrm{Na}_y \mathrm{S}$ ).

#### 1. Введение

Олово в сульфиде свинца (PbS) является изоэлектронной примесью замещения и, тем не менее, согласно данным по явлениям переноса [1] и данным мессбауэровской спектроскопии на изотопе <sup>119</sup>Sn, при малых концентрациях действует как донор [2]: для образцов  $Pb_{1-x}Sn_xS$ с электронной проводимостью, содержащих сверхстехиометрический свинец, в мессбауэровских спектрах наблюдалось только двухвалентное олово Sn<sup>2+</sup>, тогда как для образцов  $Pb_{1-x-y}Sn_xA_yS$  с дырочной проводимостью (здесь А — одноэлектронный акцептор, например натрий или таллий,  $y \ge 2x$ ) только четырехвалентное олово Sn<sup>4+</sup>. Мессбауэровские спектры были объяснены в предположении, что примесные атомы олова замещают двухвалентный свинец в кубической решетке PbS и образуют в запрещенной зоне донорные состояния: линия двухвалентного олова Sn<sup>2+</sup> отвечает нейтральным относительно катионной подрешетки состояниям ([Sn]<sup>0</sup>), а линия четырехвалентного олова Sn<sup>4+</sup> — двукратно ионизованным состояниям ([Sn]<sup>2+</sup>) донорного центра олова в PbS. Меняя соотношение концентраций олова и акцепторной примеси в PbS, можно получить любое контролируемое соотношение интенсивностей линий Sn<sup>2+</sup> и  $Sn^{4+}$  [1]. Отсутствие линии  $Sn^{3+}$  (однократно ионизованного донорного центра олова) в мессбауэровских спектрах, измеренных при температуре  $T = 80 \, {\rm K}$  на частично компенсированных образцах  $Pb_{1-x-y}Sn_xA_yS$ , указывает на то, что олово образует в PbS двухэлектронные донорные центры с отрицательной корреляционной энергией, т.е. энергия однократной ионизации этих центров больше, чем половина энергии его двукратной ионизации. Наконец, дырочный характер проводимости и отсутствие вырождения для частично компенсированных образцов  $Pb_{1-x-y}Sn_xA_yS$  указывает на то, что химический потенциал находится в нижней половине запрещенной зоны полупроводника (следовательно, донорные уровни олова в сульфиде свинца также размещены в нижней половине запрещенной зоны).

Таким образом, в запрещенной зоне полупроводника образуется две полосы локализованных состояний олова,

разделенных на величину корреляционной энергии

$$U = E_1 - E_2, \tag{1}$$

где  $E_1$  — энергия уровня, на который садится электрон, превращая центр  $\mathrm{Sn}^{3+}$  в центр  $\mathrm{Sn}^{2+}$ ,  $E_2$  — энергия уровня, на который садится электрон, превращая центр  $\mathrm{Sn}^{4+}$ в центр  $\mathrm{Sn}^{3+}$ . Плотность состояний как функция энергии в запрещенной зоне  $\mathrm{Pb}_{1-x-y}\mathrm{Sn}_x\mathrm{A}_y\mathrm{S}$  была предложена авторами [2]. Цель настоящей работы состояла в установлении температурных зависимостей химического потенциала и концентрации носителей тока.

# Температурные зависимости химического потенциала и концентрации носителей тока

Согласно распределению Гиббса, концентрация примесных центров с разным числом электронов определяется соотношением

$$\frac{N_s}{N_{s-1}} = \frac{g_s}{g_{s-1}} \exp \frac{F - E_s}{kT}.$$
 (2)

Здесь  $N_s$  и  $N_{s-1}$  — концентрации центров с s и (s-1) электронами,  $g_s$  и  $g_{s-1}$  — факторы спинового вырождения для соответствующих уровней, F — уровень химического потенциала,  $E_s$  — энергия уровня, на который садится s-й электрон, k — постоянная Больцмана.

Таким образом, для твердых растворов  $Pb_{1-x-y}Sn_xA_yS$  имеем

$$\frac{N_{\mathrm{Sn}^{2+}}}{N_{\mathrm{Sn}^{3+}}} = \frac{g_{\mathrm{Sn}^{2+}}}{g_{\mathrm{Sn}^{3+}}} \exp \frac{F - E_1}{kT}$$
(3)

И

$$\frac{N_{\mathrm{Sn}^{3+}}}{N_{\mathrm{Sn}^{4+}}} = \frac{g_{\mathrm{Sn}^{3+}}}{g_{\mathrm{Sn}^{4+}}} \exp \frac{F - E_2}{kT},\tag{4}$$

где  $N_{\text{Sn}^{2+}}$ ,  $N_{\text{Sn}^{3+}}$  и  $N_{\text{Sn}^{4+}}$  — концентрации центров  $\text{Sn}^{2+}$ ,  $\text{Sn}^{3+}$  и  $\text{Sn}^{4+}$  соответственно,  $g_{\text{Sn}^{2+}}$ ,  $g_{\text{Sn}^{3+}}$  и  $g_{\text{Sn}^{4+}}$  — факторы вырождения для центров  $\text{Sn}^{2+}$ ,  $\text{Sn}^{3+}$  и  $\text{Sn}^{4+}$  соответственно (считая, что за донорные свойства олова ответственны 5s-электроны, получим:  $g_{\text{Sn}^{2+}} = 1$ ,  $g_{\text{Sn}^{3+}} = 2$  и  $g_{\text{Sn}^{4+}} = 1$ ).



**Рис. 1.** Зависимости относительных концентраций  $\operatorname{Sn}^{2+}(a)$ ,  $\operatorname{Sn}^{3+}(b)$  и  $\operatorname{Sn}^{4+}(c)$  от положения химического потенциала в твердых растворах  $\operatorname{Pb}_{1-x-y}\operatorname{Sn}_x\operatorname{A}_y\operatorname{S}$  для случая U < 0. На вставке — область малых концентраций  $\operatorname{Sn}^{3+}$ .



**Рис. 2.** Зависимость максимальной относительной концентрации  $\operatorname{Sn}^{3+}$  в твердых растворах  $\operatorname{Pb}_{1-x-y}\operatorname{Sn}_x\operatorname{A}_y\operatorname{S}$  при 80 K от корреляционной энергии.

Поскольку

$$N_{\mathrm{Sn}^{2+}} + N_{\mathrm{Sn}^{3+}} + N_{\mathrm{Sn}^{4+}} = N_{\mathrm{Sn}},\tag{5}$$

где N<sub>Sn</sub> — общая концентрация олова, то

$$N_{\mathrm{Sn}^{2+}} = N_{\mathrm{Sn}} \left[ 1 + \frac{g_{\mathrm{Sn}^{3+}}}{g_{\mathrm{Sn}^{2+}}} \exp \frac{E_1 - F}{kT} + \frac{g_{\mathrm{Sn}^{4+}}}{g_{\mathrm{Sn}^{2+}}} \exp \frac{E_1 + E_2 - 2F}{kT} \right]^{-1},$$

$$N_{\mathrm{Sn}^{3+}} = N_{\mathrm{Sn}} \left[ 1 + \frac{g_{\mathrm{Sn}^{2+}}}{g_{\mathrm{Sn}^{2+}}} \exp \frac{F - E_1}{kT} + \frac{g_{\mathrm{Sn}^{4+}}}{g_{\mathrm{Sn}^{3+}}} \exp \frac{E_2 - F}{kT} \right]^{-1},$$

$$N_{\mathrm{Sn}^{4+}} = N_{\mathrm{Sn}} \left[ 1 + \frac{g_{\mathrm{Sn}^{3+}}}{g_{\mathrm{Sn}^{4+}}} \exp \frac{F - E_1}{kT} + \frac{g_{\mathrm{Sn}^{4+}}}{g_{\mathrm{Sn}^{4+}}} \exp \frac{F - E_1}{kT} + \frac{g_{\mathrm{Sn}^{4+}}}{g_{\mathrm{Sn}^{4+}}} \exp \frac{F - E_1}{kT} \right]^{-1}.$$

$$(6)$$

Зависимости  $N_{\text{Sn}^{2+}}$ ,  $N_{\text{Sn}^{3+}}$  и  $N_{\text{Sn}^{4+}}$  от F для U < 0 представлены на рис. 1 (в согласии с данными

авторов [3] использованы величины: |U| = 0.06 эВ,  $E_1 = 0.04$  эВ,  $E_2 = 0.10$  эВ, энергия отсчитывается от вершины валентной зоны). Максимальная концентрация Sn<sup>3+</sup> (с точностью до  $kT \ln(g_{\text{Sn}^{3+}}/g_{\text{Sn}^{4+}}))$  достигается при  $F = (E_1 + E_2)/2$ , и она определяется как

$$[N_{\rm Sn^{3+}}]_{\rm max} = N_{\rm Sn} \left[ 1 + 2 \, \frac{\sqrt{g_{\rm Sn^{2+}} g_{\rm Sn^{4+}}}}{g_{\rm Sn^{3+}}} \exp\left(-\frac{U}{kT}\right) \right]^{-1}.$$
 (7)

Зависимость  $[N_{\text{Sn}^{3+}}]_{\text{max}}$  от корреляционной энергии для температуры 80 К приведена на рис. 2. Видно, что при выполнении условия |U| > 0.06 эВ (экспериментальные данные авторов [3]) для случая отрицательной корреляционной энергии  $[N_{\text{Sn}^{3+}}]_{\text{max}} \ll N_{\text{Sn}}$ , и этим объясняются трудности наблюдения центров  $\text{Sn}^{3+}$  в мессбауэровских спектрах <sup>119</sup>Sn.

Плотность положительного заряда на центрах олова (в единицах заряда электрона) есть

$$o = 2N_{\mathrm{Sn}^{4+}} + N_{\mathrm{Sn}^{3+}}$$
  
=  $N_{\mathrm{Sn}} \frac{2 + (g_{\mathrm{Sn}^{3+}}/g_{\mathrm{Sn}^{4+}}) \exp[(F - E_2)/kT]}{1 + \frac{g_{\mathrm{Sn}^{3+}}}{g_{\mathrm{Sn}^{4+}}} \exp \frac{F - E_2}{kT} + \frac{g_{\mathrm{Sn}^{2+}}}{g_{\mathrm{Sn}^{4+}}} \exp \frac{2F - E_1 - E_2}{kT}},$  (8)

и отсюда следует, что для случая U < 0 заряд на центрах  $\mathrm{Sn}^{3+}$  необходимо учитывать только при  $F \ge E_2$ . При  $F = E_2$ 

$$\rho = N_{\rm Sn} \, \frac{4}{3 + \exp(-U/kT)}$$

и при  $F = (E_1 + E_2)/2$  имеем  $\rho = N_{\text{Sn}}$ .

Уравнение электронейтральности для твердых растворов Pb<sub>1-x-v</sub>Sn<sub>x</sub>A<sub>v</sub>S в общем случае имеет вид

$$2N_{\mathrm{Sn}^{4+}} + N_{\mathrm{Sn}^{3+}} + p = N_{\mathrm{A}},\tag{9}$$

где p — концентрация дырок, а  $N_A$  — концентрация одноэлектронных акцепторов. Для области примесной проводимости  $p \ll N_{\text{Sn}}$ ,  $N_A$  и уравнение электронейтральности в развернутом виде может быть записано как

$$N_{\rm Sn} \frac{2 + (g_{\rm Sn^{3+}}/g_{\rm Sn^{4+}}) \exp[(F - E_2)/kT]}{1 + \frac{g_{\rm Sn^{3+}}}{g_{\rm Sn^{4+}}} \exp\frac{F - E_2}{kT} + \frac{g_{\rm Sn^{2+}}}{g_{\rm Sn^{4+}}} \exp\frac{2F - E_1 - E_2}{kT}}{kT} = N_{\rm A}.$$
(10)

Если ввести обозначения

$$x = F - \frac{E_1 + E_2}{2}$$
  $x^2 = \exp{\frac{2F - E_1 - E_2}{kT}} = \exp{\frac{2x}{kT}},$ 

уравнение (10) сводится к квадратному уравнению относительно *z*:

$$\frac{g_{\mathrm{Sn}^{2+}}}{g_{\mathrm{Sn}^{4+}}}z^2 + \frac{g_{\mathrm{Sn}^{3+}}}{g_{\mathrm{Sn}^{4+}}}\exp\frac{U}{kT}\cdot\left(1-\frac{N_{\mathrm{Sn}}}{N_{\mathrm{A}}}\right)z + \left(1-\frac{2N_{\mathrm{Sn}}}{N_{\mathrm{A}}}\right) = 0.$$
(11)

Решив это уравнение, можно определить температурную зависимость химического потенциала F. Мы ограничимся рассмотрением случая U < 0 для двух областей в зависимости F(T), принципиально различающихся соотношением между  $N_{\text{Sn}^{3+}}$  и  $N_{\text{Sn}^{4+}}$ .

Физика и техника полупроводников, 2005, том 39, вып. 3

Область I:  $N_{\mathrm{Sn}^{3+}} \gg N_{\mathrm{Sn}^{4+}}$ , или  $p \approx N_{\mathrm{Sn}^{3+}} = N_{\mathrm{A}}$ . Этот случай реализуется при  $F - E_2 \gg kT$ 

(т. е.  $\exp(F - E_2)/kT \gg 1$ ), когда имеет место малая степень компенсации олова акцепторной примесью (т. е.  $N_{\text{Sn}} \gg N_{\text{A}}$ ), так что тем более выполняется условие  $F - (E_1 + E_2)/2 \gg kT$  (т. е.  $\exp[(2F - E_1 - E_2)/kT] \gg \exp[(F - E_2)/kT] \gg 1$ ).

Тогда уравнение (11) сводится к уравнению

$$z = \frac{N_{\mathrm{Sn}}g_{\mathrm{Sn}^{3+}}}{N_{\mathrm{A}}g_{\mathrm{Sn}^{2+}}} \exp \frac{U}{kT}$$
(12)

и температурная зависимость химического потенциала имеет вид

$$F = E_1 + kT \ln \left[ \frac{N_{\text{Sn}}}{N_{\text{A}}} \frac{g_{\text{Sn}^{3+}}}{g_{\text{Sn}^{2+}}} \right].$$
 (13)

При  $\rho \ll N_{\text{Sn}}$  и  $F > (E_1 + E_2)/2$  имеем  $[dF/dT]_{\rho=\text{const}} > 0$ . Таким образом, если  $F > E_2$ , то уровень химического потенциала поднимается с ростом температуры при  $\rho = \text{const.}$ 

При выполнении условия (13) температурная зависимость концентрации дырок имеет вид

$$p = N_V \exp\left[\frac{E_V - F}{kT}\right] = N_V \frac{N_A}{N_{\text{Sn}}} \frac{g_{\text{Sn}^{2+}}}{g_{\text{Sn}^{3+}}} \exp\left[\frac{E_V - E_1}{kT}\right],$$
(14)

где  $N_V$  — эффективная плотность состояний вблизи вершины валентной зоны, при вычислении которой следует учитывать поправку Кейна на непараболичность валентной зоны PbS;  $E_V$  — энергия вершины валентной зоны.

Область II:  $N_{\mathrm{Sn}^{3+}} \ll N_{\mathrm{Sn}^{4+}}$ , или  $p = 2N_{\mathrm{Sn}^{4+}} = N_{\mathrm{A}}$ .

Этот случай реализуется при  $F < E_2$ , когда имеет место большая степень компенсации олова акцепторной примесью, причем выполняется либо условие  $2N_{\rm Sn} - N_{\rm A} \ll N_{\rm A}$ , но при этом  $2N_{\rm Sn} - N_{\rm A} > 0$  (т. е.  $0 < 2N_{\rm Sn} - N_{\rm A} \ll N_{\rm A}$ ), либо условие  $\exp(U/kT) \ll 1$  (т. е.  $|U| \gg kT$ ) — иными словами, в области низких температур.

Тогда уравнение (11) сводится к уравнению

$$N_{\rm Sn} \frac{2}{(g_{\rm Sn^{2+}}/g_{\rm Sn^{4+}}) \exp[(2F - E_1 - E_2)/kT] + 1} = N_{\rm A}, \ (15)$$

так что температурная зависимость химического потенциала имеет вид

$$F = \frac{E_1 + E_2}{2} + kT \ln\left(\frac{g_{\mathrm{Sn}^{4+}}}{g_{\mathrm{Sn}^{2+}}} \frac{2N_{\mathrm{Sn}} - N_{\mathrm{A}}}{N_{\mathrm{A}}}\right), \qquad (16)$$

и поскольку  $2N_{
m Sn} - N_{
m A} \ll N_{
m A}$ , то

$$\ln\left(\frac{g_{\mathrm{Sn}^{4+}}}{g_{\mathrm{Sn}^{2+}}}\frac{2N_{\mathrm{Sn}}-N_{\mathrm{A}}}{N_{\mathrm{A}}}\right) < 0$$

что соответствует  $[dF/dT]_{
ho={\rm const}} < 0,$  когда  $F < (E_1 + E_2)/2.$ 

При выполнении условия (16) температурная зависимость концентрации дырок имеет вид

$$p = N_V \exp \frac{E_V - F}{kT}$$
$$= N_V \sqrt{\frac{g_{\text{Sn}^{4+}}}{g_{\text{Sn}^{2+}}}} \frac{2N_{\text{Sn}} - N_A}{N_A}}{N_A} \exp \frac{E_V - (E_1 + E_2)/2}{kT}.$$
 (17)

#### 3. Экспериментальные результаты

Сравнивая уравнения (14) и (17), можно сделать вывод, что энергия активации, определяемая из температурной зависимости концентрации дырок, в образцах Pb<sub>1-x-v</sub>Sn<sub>x</sub>A<sub>v</sub>S должна зависеть от соотношения концентраций олова и акцепторной примеси. В качестве примера на рис. З приведены температурные зависимости концентрации дырок для твердых растворов Pb<sub>0.94</sub>Sn<sub>0.05</sub>Na<sub>0.01</sub>S и Pb<sub>0.985</sub>Sn<sub>0.005</sub>Na<sub>0.01</sub>S. Для Pb<sub>0.94</sub>Sn<sub>0.05</sub>Na<sub>0.01</sub>S получены значения энергии активации для примесной проводимости (T < 450 K)  $E_{01} = (0.080 \pm 0.002)$  эВ и для собственной проводимости (T > 450 K)  $E_{02} = (0.217 \pm 0.002)$  эВ. Для Рb0.985Sn0.005Na0.01S получены значения энергии активации для примесной проводимости (*T* < 500 K)  $E_{01} = (0.099 \pm 0.002)$  эВ и для собственной проводимости  $(T > 500 \text{ K}) E_{02} = (0.211 \pm 0.002)$  эВ.

Таким образом, для образцов  $Pb_{0.94}Sn_{0.05}Na_{0.01}S$ и  $Pb_{0.985}Sn_{0.005}Na_{0.01}S$  энергии активации в области примесной проводимости различаются на величину ~ 0.02 эВ, что соответствует U = 0.04 эВ и согласуется с данными по определению величины U из измерений методом мессбауэровской спектроскопии частоты электронного обмена между нейтральными и ионизованными центрами олова в твердых растворах  $Pb_{1-x-y}Sn_xA_yS$  [3].



**Рис. 3.** Температурные зависимости концентрации дырок для образцов  $Pb_{0.94}Sn_{0.05}Na_{0.01}S(a)$  и  $Pb_{0.985}Sn_{0.005}Na_{0.01}S(b)$ .

Физика и техника полупроводников, 2005, том 39, вып. 3

# 4. Заключение

Получена зависимость концентрации промежуточного зарядового состояния  $\mathrm{Sn}^{3+}$  двухэлектронных центров олова в PbS от корреляционной энергии и показано, что это состояние олова не может быть обнаружено с помощью мессбауэровской спектроскопии на изотопе <sup>119</sup>Sn из-за недостаточной чувствительности. Однако состояние  $\mathrm{Sn}^{3+}$ , по-видимому, проявляется в температурной зависимости концентрации дырок в твердых растворах  $\mathrm{Pb}_{1-x-y}\mathrm{Sn}_x\mathrm{A}_y\mathrm{S}$ .

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 02-02-17306).

# Список литературы

- Л.В. Прокофьева, М.Н. Виноградова, С.В. Зарубо. ФТП, 14, 2201 (1980).
- [2] Ф.С. Насрединов, С.А. Немов, В.Ф. Мастеров, П.П. Серегин. ФТТ, **41**, 1897 (1999).
- [3] В.Ф. Мастеров, Ф.С. Насрединов, С.А. Немов, П.П. Серегин. ФТП, **31**, 291 (1997).

Редактор Л.В. Шаронова

# Statistics of electrons in PbS with *U*-centres

S.A. Nemov, F.S. Nasredinov, P.P. Seregin, N.P. Seregin, E.S. Khuzhakulov\*

St. Petersburg State Politechnical University, 195251 St. Petersburg, Russia \* Tashkent Regional State Pedagogical Institute, 702500 Angren, Uzbekistan